

**Физико-Технический Институт им. А.Ф.Иоффе РАН**

**10-я Всероссийская конференция  
НИТРИДЫ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ И АЛЮМИНИЯ –  
СТРУКТУРЫ И ПРИБОРЫ**

**23-25 марта 2015 года**



**ПРОГРАММА**

**Санкт-Петербург  
2015**

## **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ**

П.С. Копьев, <i>председатель</i>	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
А.А. Федянин	МГУ им. М.В.Ломоносова
А.Н. Туркин	МГУ им. М.В.Ломоносова
В.В. Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
А.Е. Николаев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
П.Ю. Боков	МГУ им. М.В.Ломоносова
В.П. Чалый	Светлана - Рост
Е.Е. Заварин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
Г.В. Иткинсон	Тетис
Д.А. Бауман	Светлана - Оптоэлектроника
Н.И. Каргин	МИФИ
А.А. Мармалюк	НИИ «Полнос»
О.В. Снегирев	МГУ им. М.В.Ломоносова
Е.В. Каевицер	НПП «Пульсар»
А.Е. Балакирев	Prochip

## **ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ**

П.С. Копьев, <i>председатель</i>	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
А.Э. Юнович, <i>со-председатель</i>	МГУ им. М.В.Ломоносова
А.В. Сахаров	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
К.С. Журавлев	ИФП СО РАН
С.В. Иванов	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
А.Е. Романов	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
С.Ю. Карпов	Софт-Импакт
Л.М. Коган	НПЦ «Оптэл»
Е.В. Луценко	ИФ НАН Беларуси
В.В. Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
М.С. Шаталов	Sensor Electronic Technology
Д.А. Закгейм	Светлана - Оптоэлектроника
В.Г. Сидоров	СПБГПУ
В.М. Устинов	ФТИ им. А.Ф.Иоффе
С.Ю. Шаповал	ИПТМ РАН
В.Н. Данилин	НПП "Пульсар"
А.Ф. Цацульников	ФТИ им. А.Ф.Иоффе

23 марта

Регистрация	9:00-10:00
<b>Открытие конференции</b>	
<u>А.Э. Юнович</u> Нобелевская премия по физике 2014 года и проблемы исследований и разработок структур и приборов на основе нитридных полупроводников	10:00 - 10:15
<b>Сессия «Приборы на основе III-N»</b>	
<u>Н.В. Кузнецова, Д.В. Нечаев, Н.М. Шмидт, М.М. Кулагина, Д.Ю. Казанцев, Б.Я. Бер, Т.А. Комиссарова, Н.В. Ржеуцкий, Е.В. Луценко, Л.М. Балясный, А.Л. Дятлов, В.Е. Земляков, С.Ю. Карпов, С.В. Иванов, В.Н. Жмерик</u> AlGaIn УФ фотоприемники для солнечно слепого спектрального диапазона, изготовленные при помощи ПАМПЭ	10:15 - 10:30
<u>А.С. Усиков, М.В. Пузык, С.Ю. Курин, Н.М. Шмидт, И.Н. Смирнова, С.И. Трошков, И.А. Ермаков, Д. С. Ковалев, Б.П. Папченко, Х. Хелава, Ю.Н. Макаров</u> Применение слоев нитрида галлия для фотоэлектролиза воды	10:30 - 10:45
<u>С.А. Сергеев, О.С. Сенатов, Б.В. Сергеева</u> Граничная частота усиления волн пространственного заряда в тонкопленочных полупроводниковых структурах на основе нитрида индия	10:45 - 11:00
<u>А.И. Стогний, Д.В. Луцев, Н.Н. Новицкий, А.В. Беспалов, О.Л. Голикова, В.А. Кецо</u> Гетероструктуры $Y_3Fe_5O_{12}$ / GAN: синтез, распространение спиновых волн и приборы свч диапазона на их основе	11:00 - 11:15
<b>Перерыв – чай, кофе</b>	11:15 - 11:45

<b>Сессия «Оптические свойства и наноструктуры»</b>	
<b><u>П.А. Бохан, Д.Э. Закревский, Т.В. Малин, И.В. Осинных, К.С. Журавлев</u></b> Сверхлюминесценция слоев AlGa <sub>N</sub> , сильно легированных кремнием	11:45 - 12:00
<b><u>И.А. Александров, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев</u></b> Модель температурного тушения фотолюминесценции структур с квантовыми точками GaN/AlN	12:00 - 12:15
<b><u>Н.В. Ржеуцкий, Е.В. Луценко, В.Н. Павловский, Г.П. Яблонский, М. Aljohenii, A. Aljerwii, A. Alyatani, В.Н. Жмерик, Д.В. Нечаев, С.В. Иванов</u></b> Фотолюминесценция гетероструктур с квантовыми ямами AlGa <sub>N</sub> в зависимости от режимов субмонослойной импульсной эпитаксии	12:15 - 12:30
<b><u>В.В. Чалдышев, А.С. Большаков, Е.Е. Заварин, А.В. Сахаров, В.В. Лундин, А.Ф. Цацульников, М.А. Яговкина</u></b> Оптические решетки экситонов на основе системы квантовых ям InGa <sub>N</sub> /Ga <sub>N</sub>	12:30 - 12:45
<b><u>Н.А. Торхов, А.В. Новиков, Д.А. Бабанакоев, Т.В. Зарецкая</u></b> Влияние фрактальной геометрии гетероэпитаксиальных AlGa <sub>N</sub> /Ga <sub>N</sub> структур на размерные эффекты их электрофизических характеристик	12:45 - 13:00
<b><u>Н.М. Шмидт, Е.А. Шабунина, А.С. Усиков, А.Л. Закгейм, А.П. Карташова, М.Е. Левинштейн, С.Ю. Курин, В.В. Ратников, А.Е. Черняков, Х. Хелава, Ю. Макаров</u></b> Особенности дефектообразования в InGa <sub>N</sub> /Ga <sub>N</sub> и AlGa <sub>N</sub> /Ga <sub>N</sub> светодиодах	13:00 - 13:15
<b><u>Н.М. Шмидт, А.А. Грешинов, М.М. Мездрогина, В.Г. Сидоров, Н.А. Тальнишних, А.Е. Черняков, Е.И. Шабунина</u></b> Фрактальная природа светоизлучающих структур на основе III-N наноматериалов и связанные с ней явления	13:15 - 13:45
<b>Обед</b>	13:45 - 15:00

<b>Сессия «Светодиоды 1»</b>	
<b><u>К.А. Булашевич, А.В. Кулик, С.Ю. Карпов, А.Е. Черняков, А.В. Аладов, Н.А. Тальнишних, А.Л. Закгейм</u></b> Оптимизация смешения цветов для перестраиваемых твёрдотельных источников белого света	15:00 - 15:15
<b><u>А.С. Евсеенков, В.И. Зубков, Т.А. Орлова, А.В. Зубкова, С.А. Тарасов</u></b> Расчет вывода излучения из светодиодной структуры с текстурированными интерфейсами	15:15 - 15:30
<b><u>А.В. Мазалов, Д.Р. Сабитов, В.А. Курешов, А.А. Падалица, А.А. Мармалюк, Р.Х. Акчурун</u></b> Использование профилированных сапфировых подложек для выращивания светодиодных гетероструктур InGaN/GaN	15:30 - 15:45
<b><u>В.А. Большухин, Т.М. Борисова, Л.Н. Зорина, В.В. Приходько, В.Н. Личманова, Н.П. Сошин</u></b> Зеленые, зелено-желтые фотолуминофоры возбуждаемые нитридными гетероструктурами с высокой эффективностью	15:45 - 16:00
<b><u>И.С. Романов, И.А. Прудаев, В.В. Копьев, А.А. Мармалюк, В.А. Курешов, Д.Р. Сабитов, А.В. Мазалов</u></b> Влияние толщины последнего барьерного слоя на внутреннюю и внешнюю квантовую эффективность светодиодных структур InGaN/GaN	16:00 - 16:15
<b>Перерыв – чай, кофе</b>	16:15 - 16:30

Сессия «Светодиоды 2»	
<b><u>А.Е. Черняков, А.Л. Закгейм, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов</u></b> Сравнение растекания тока и тепла в мощных AlInGaN светодиодах ультрафиолетового (360 нм) и зеленого (530 нм) спектральных диапазонов	16:30 - 16:45
<b><u>Л.П. Авакяни, А.Э. Асланян, К.Ю. Положенцев, П.Ю. Боков, А.В. Червяков</u></b> Оценка неоднородности встроенных электрических полей в активной области множественных квантовых ям светодиодной гетероструктуры InGaN/AlGaN/GaN методом спектроскопии электроотражения	16:45 - 17:00
<b><u>В.А. Сергеев, И.В. Фролов, А.А. Широков</u></b> Исследование спада квантовой эффективности зеленых InGaN светодиодов на фиксированных длинах волн излучения	17:00 - 17:15
<b><u>И.Н. Яковлев, В.И. Зубков, О.В. Кучерова, В.Н. Черкасова</u></b> Вольт-фарадные исследования гетероструктур InGaN/GaN: анализ встроенных электрических полей	17:15 - 17:30
<b><u>А.В. Мазалов, М.М. Зверев, Н.А. Гамов, В.Б. Студенов, В.А. Курешов, Д.Р. Сабитов, А.А. Падалица, А.А. Мармалюк, В.И. Козловский</u></b> Расходимость излучения лазеров с электронно-лучевой и оптической накачками на основе квантоворазмерной структуры AlGaInGaN/GaN	17:30 - 17:45

<b>Стендовая сессия А</b>	17:45 - 18:45
---------------------------	---------------------

<b>Фуршет</b>	19:00 - 21:00
---------------	---------------------

24 марта

<b>Сессия «МВЕ»</b>	
<b><u>И.С. Езубченко, И.О. Майборода, М.Л. Занавескин</u></b> Рост и исследование гетероструктур с тонкими барьерными слоями AlN и Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> N выращенных методом аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии	9:30- 9:45
<b><u>Д.М. Красовицкий, А.Л. Дудин, С.В. Кокин, Н.И. Кацавец, А.Г. Филаретов, В.П. Чалый</u></b> Развитие стандартных технологий III-нитридов в ЗАО «Светлана-Рост»	9:45- 10:00
<b><u>Д.В. Нечаев, В.В. Ратников, Н.В. Кузнецова, С.В. Трошков, П.Н. Брунков, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов</u></b> Рост низкодефектных темплейтов AlN и GaN на подложках с-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 6H-SiC и Si(111) методом плазменно-активированной молекулярно-пучковой эпитаксии	10:00 - 10:15
<b><u>Т.В. Малин, Д.С. Милахин, В.Г. Мансуров, Ю.Г. Галицын, А.С. Кожухов, В.В. Ратников, А.Н. Смирнов, В.Ю. Давыдов, К.С. Журавлёв</u></b> Влияние нитридизации сапфира и зарождения слоёв AlN на морфологию и структурное совершенство пленок AlN, выращенных методом аммиачной МЛЭ	10:15 - 10:30
<b><u>В.Г. Мансуров, Т.В. Малин, Ю.Г. Галицын, К.С. Журавлев</u></b> Получение графеноподобного AlN на поверхности (111)Si методом аммиачной МЛЭ	10:30 - 10:45
<b><u>Ю.В. Грищенко., И.С. Езубченко, М.Л. Занавескин, И.О. Майборода</u></b> Влияние морфологии зародышевых слоев AlN и AlGaN на токи утечек в НЕМТ структурах	10:45 - 11:00
<b>Перерыв – чай, кофе.</b>	11:00 - 11:15

<b>Сессия «МОСVD»</b>	
<b><u>V. Foltynski, A. Boyd, T. Korst, J. Lindner, M. Deufel, M. Heuken</u></b> GaN наноструктуры созданные газофазной эпитаксией	11:15 - 11:45
<b><u>В.В.Лундин, Е.Е. Заварин, М.Г.Попов,, А.В. Сахаров,, А.Ф. Цацульников, Е.В.Яковлев, Д.С.Базаревский, Р.А.Талалаев</u></b> МОС-гидридная эпитаксия III-N гетероструктур: как технология должна влиять на бизнес	11:45 - 12:15
<b><u>А.А.Арендаренко, И.Г.Ермошин, В.А.Орешкин, Ю.Н.Свешников, И.Н.Цыпленков</u></b> Влияние чистоты технологических газов на рост и характеристики гетероэпитаксиальных структур AlGaIn/GaN, получаемых МОС-гидридным методом	12:15 - 12:30
<b><u>А.С. Сегаль, Е.В. Яковлев, С.Ю. Карпов, М.Э. Рудинский, А.В. Лобанова, Р.А. Талалаев</u></b> Управление профилем состава и напряжений в приборных гетероструктурах на основе InGaIn	12:30 - 12:45
<b><u>В.Г. Дубровский</u></b> Синтез нитевидных нанокристаллов нитрида галлия и гетероструктур: сравнение технологий МВЕ и МОСVD	12:45 - 13:00
<b><u>М.М. Рожавская,, В.В. Лундин,, С.И. Трошков, А.А. Васильев,, В.Ю. Давыдов, С.О.Усов, Е.Ю. Лундина,, Д.А. Кириленко, А.Ф. Цацульников,, В.Г. Дубровский</u></b> Синтез нитевидных микро- и нанокристаллов нитрида галлия с рекордной скоростью роста	13:00 - 13:15
<b><u>М.Э. Рудинский, А.В. Лобанова, Е.В. Яковлев, М.С. Рамм, Р.А. Талалаев</u></b> Контроль напряжений и плотности дислокаций в технологии GaN-on-Si	13:15 - 13:30
<b>Обед</b>	13:30 - 14:30



<b>Сессия «НЕМТ» 1</b>	
<b><u>Ю.В. Федоров</u></b> Нитридные НЕМТ против арсенидных: последняя битва?	14:30 - 14:45
<b><u>А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, Е.Е. Заварин, А.В. Сахаров, Н.К. Травин, О.В. Венедиктов, В.П. Иванова, Я.М. Парнес, В.Е. Земляков, В.В. Волков, В.Н. Вьюгинов, М.А. Яговкина, В.Р. Тихомиров, М.Н. Мизеров</u></b> Рост НЕМТ гетероструктур AlGaIn/GaN на подложках SiC отечественного производства	14:45 - 15:00
<b><u>Л.Э. Великовский, П.Е. Сим, Ю.Н. Поливанова, Д.А. Шишкин, В.В. Лундин, Е.Е.Заварин, А.Ф. Цацульников</u></b> Разработка мощных GaN транзисторов L-S-C диапазона	15:00 - 15:15
<b><u>Ю.В Грищенко., И.С. Езубченко, И.О. Майборода, Ю.В. Федоров, М.Л. Занавескин</u></b> Исследования и разработки в области создания СВЧ МИС на базе нитридных гетероструктур в НИЦ «Курчатовский Институт	15:15 - 15:30
<b><u>А.Н. Алексеев, Д.М. Красовицкий, С.И. Петров, В.П. Чалый, В.В. Мамаев, В.Г. Сидоров</u></b> Особенности использования аммиачной и плазменной МЛЭ для получения III-N НЕМТ гетероструктур	15:30 - 15:45
<b>Перерыв – чай, кофе</b>	15:45 - 16:00

<b>Сессия «HEMT» 2</b>	
<b><u>Н.А. Андрианов, Е.В. Вознюк, С.В. Кокин</u></b> Воздействие N <sub>2</sub> плазмы на свойства HEMT на основе AlGaIn/GaN	16:00 - 16:15
<b><u>Ю.В. Федоров, Д.Л. Гнатюк, А.С. Бугаев, О.С. Матвеевко, Р.Р. Галиев, А.В. Зуев</u></b> Разработка многофункциональных СВЧ МИС для ПППМ Ка и V-диапазонов на гетероструктурах AlGaIn/GaN и технологии их изготовления	16:15 - 16:30
<b><u>М.Н. Кондаков, С.В. Черных, Н.Б. Гладышева, А.В. Черных, А.А. Дорофеев, С.И. Диденко, К.Д. Щербачев</u></b> Исследование омических контактов на основе системы Mo/Al/Mo/Au к AlGaIn/GaN гетероструктурам	16:30 - 16:45
<b><u>G. Atmaca, T. Malin, E. Kutlu, S. Ardali, P. Narin, B. Мансуров, B. Sarikavak-Lisesivdin, S. B. Lisesivdin, E. Tiras, K. Журавлев</u></b> Эффект <i>in-situ</i> Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> пассивации на энергетическую релаксацию горячих электронов в AlGaIn/GaN гетероструктурах	16:45 - 17:00
<b><u>С.В. Михайлович, Р.Р. Галиев, Ю.В. Фёдоров, М.Ю. Щербакова</u></b> Разработка технологии изготовления двухзатворных немет миллиметрового диапазона на нитридных гетероструктурах	17:00 - 17:15
<b>Стендовая сессия В</b>	<b>17:15</b> - <b>18:15</b>
<b>Круглый стол</b>	<b>18:15</b> - <b>19:30</b>
<b>Ужин</b>	<b>18:00</b> - <b>20:00</b>

25 марта

<b>Сессия «Подложки для III-N эпитаксии и рост объемных кристаллов»</b>	
<b><i>П.А. Аверичкин, А.А. Донсков, М.П. Духновский, В.С. Ежлов, С.Н. Князев, Ю.П. Козлова, Т.Г. Югова</i></b> Использование буферных карбидкремнийоксидных слоев на полупроводниковых и диэлектрических подложках для эпитаксии слоёв нитрида галлия	9:30- 9:45
<b><i>Ш.М. Рамазанов, Д.С. Даллаева, Г.М. Рамзанов, Р.М. Эмиров, Н.М. Алиханов</i></b> Гибридные подложки карбида кремния на кремнии для эпитаксии нитридов III-группы	9:45- 10:00
<b><i>В.Н. Бессолов, Ю.В. Жилиев, А.Е. Калмыков, Е.В. Коненкова, С.А. Кукушкин, А.В. Мясоедов, Л.М. Сорокин, С.Н. Родин, М.П. Щеглов</i></b> Полуполярный GaN на Si(100): роль SiC и AlN буферных слоев	10:00 - 10:15
<b><i>А.М. Исмаилов, С.М. Гаматаев, Л.Л. Эмирасланова, А.И. Алиев, М.Р. Рабаданов</i></b> Эпитаксиальная структура ZnO/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : синтез, структура, морфология	10:15 - 10:30
<b><i>К.Л. Енишерлова, Т.Ф. Русак, В. И. Корнеев</i></b> Влияние качества подложек SiC на структурное совершенство и некоторые электрические параметры пленок AlGaN/GaN	10:30 - 10:45
<b><i>Е. В. Луценко, Н. В. Ржеуцкий, В. Н. Павловский, Г. П. Яблонский, М. Aljohenii, A. Aljerwii, A. Alyamani, C. Mauder, B. Reuters, H. Kalisch, M. Heuken,, A. Vescan</i></b> Оптические и структурные свойства эпитаксиальных слоев GaN на подложках LiAlO <sub>2</sub> и их связь с плотностью дефектов упаковки базовой плоскости	10:45 - 11:00
<b>Перерыв – чай, кофе.</b>	11:00 - 11:15

<b>Сессия «Радиационная стойкость»</b>	
<b><u>П.С. Вергелес, Е.Б. Якимов</u></b> Влияние облучения электронами низкой энергии на оптические свойства InGaN/GaN структур: релаксация напряжений в квантовых ямах?	11:15 - 11:30
<b><u>В.И. Олешко, С.Г. Горина</u></b> Морфология разрушений, образующихся в гетероструктурах InGaN/GaN под действием сильнофокусированного электронного пучка	11:30 - 11:45
<b><u>А.В. Градобоев, Д.Д. Каримбаев, И.А. Асанов</u></b> Влияние материалов конструкции на стойкость светодиодов InGaN к облучению гамма-квантами	11:45 - 12:00
<b><u>А.А. Лебедев, С.В. Белов, М.Г. Мынбаева, А.М. Стрельчук, Е.В. Богданова, Ю.Н. Макаров, А.С. Усиков, С.Ю. Курин, И.С. Бараиш, А.Д. Роенков, В.В. Козловский</u></b> Радиационная стойкость HVPE-GaN диодов шоттки	12:00 - 12:15
<b><u>Н.А. Торхов, В.Г. Божков, А.В. Градобоев</u></b> Влияние гамма-облучения на статические характеристики Ni-GaN контактов с барьером шоттки	12:15 - 12:30
<b><u>В.Г. Горячев, К.Л. Енишерлова, С.А. Капилин</u></b> Влияние гамма облучения на параметры гетероструктур AlGaIn/GaN	12:30 - 12:45

<b>Подведение результатов и закрытие конференции</b>	<b>13:00</b> - <b>13:15</b>
--	-----------------------------------

	<b>Стендовая сессия А</b>
1	<b><u>Ю.В Холопова, А.Ф. Цацульников, Е.А. Полушкин, В.Е. Земляков, Н.Е. Антонова, С.Ю. Шаповал</u></b> Оптические характеристики AlGaIn/InGaIn/GaN светодиодных структур с сетчатым р-электродом
2	<b><u>С. Раевски, Ю.В. Жиляев, Л. Горчак, В. Ботнарюк, Д. Дука, М. Добромир, Д. Лука, Т. Потлог</u></b> Фотоэлектронная спектроскопия слоев GaN, выращенных на кремнии методом HVPE
3	<b><u>В.С. Солдаткин, В.И. Туев, А.В. Иванов, А.Ю. Олисовец, Ю.В. Ряполова, А.П. Алексеев</u></b> Исследование макетных образцов светодиодных ламп общего назначения, изготовленных на основе светодиодных линеек
4	<b><u>О.С. Медведев, О.Ф. Вывенко, А.С. Бондаренко, В.В. Вороненков</u></b> Люминесценция свежевведенных а-винтовых дислокаций в низкоомном нитриде галлия
5	<b><u>В.Е. Удальцов, А.А. Титова, А.В. Желаннов</u></b> Ультрафиолетовый диод с керамическим основанием и пластмассовой линзой
6	<b><u>Е.С. Колодезный, М.А. Швалева, В.С. Серебрякова, В.Е. Бугров, А.Е. Романов</u></b> Теплообмен в люминофорсодержащих слоях с различными матрицами в структуре мощных светодиодов
7	<b><u>М.А. Швалева, Е. Шульга, И. Кинк, А.Е. Романов, К.Д. Мынбаев, В.Е. Бугров</u></b> Исследование нового люминофорного материала на основе раствора жидкого стекла Na <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub> для белых светодиодов
8	<b><u>Е. В. Луценко, Н. В. Ржеуцкий, В. Н. Павловский, Г. П. Яблонский, М. Aljohenii, A. Aljerwii, A. Alyamani</u></b> Кинетика перегрева активной области InGaIn лазерного диода при импульсном возбуждении
9	<b><u>Н. В. Ржеуцкий, Е. В. Луценко, В. Н. Павловский, Г. П. Яблонский, М. Aljohenii, A. Aljerwii, A. Alyamani, С. Mauder, В. Reuters, Н. Kalisch, М. Heuken, А. Vescan</u></b> Влияние хвостов зон локализованных состояний на поляризацию фото- и электролюминесценции гетероструктур с квантовыми ямами InGaIn/GaN, выращенных в m-плоскости

10	<b><u>А.В. Сахаров</u>, <u>В.В. Лундин</u>, <u>Е.Е. Заварин</u>, <u>А.Е. Николаев</u>, <u>А.Ф. Цацульников</u>, <u>С.О. Усов</u>, <u>Н.А. Черкашин</u>, <u>М.Н. Корытов</u>, <u>Н.В. Рэсеуцкий</u>, <u>Е.В. Луценко</u></b> Особенности люминесценции слоев InGaN и сверхрешеток InGaN/GaN
11	<b><u>В.А. Сергеев</u>, <u>И.В. Фролов</u>, <u>А.А. Широков</u></b> Диагностика зеленых InGaN светодиодов по НЧ шуму
12	<b><u>Л.М. Коган</u>, <u>Н.А. Гальчина</u>, <u>А.Л. Гофштейн-Гардт</u>, <u>Н.П. Социн</u>, <u>А.Н. Туркин</u></b> Мощный однокристалльный белый светодиод
13	<b><u>Л.М. Коган</u>, <u>А.Л. Гофштейн-Гардт</u>, <u>А.А. Колесников</u>, <u>А.Н. Туркин</u></b> Светодиоды белого свечения с силой света до 5000 КД
14	<b><u>С.Н. Маркова</u>, <u>И.С. Матешев</u>, <u>Ю.П.Тимонин</u>, <u>А.Н.Туркин</u>, <u>К.С. Федоренко</u></b> Изменение параметров светодиодов белого свечения при длительной работе
15	<b><u>М.В. Еременко</u>, <u>М.М. Мездрогина</u>, <u>В.С. Левицкий</u>, <u>В.Н. Жмерик</u>, <u>А.Я. Виноградов</u>, <u>С.Н. Родин</u></b> Влияние напряжений на гетеро-границе структур n-ZnO/p-GaN на вид спектров электролюминесценции
16	<b><u>И.А. Александров</u>, <u>В.Г. Мансуров</u>, <u>К.С. Журавлев</u></b> Исследование энергетической структуры глубоких центров в AlN методом фотолюминесценции
17	<b><u>Е.Н. Вигдорovich</u></b> Комплексообразование при легировании нитрида галлия переходными металлами
18	<b><u>Л.К. Марков</u>, <u>И.П. Смирнова</u>, <u>М.В. Кукушкин</u>, <u>А.С. Павлюченко</u>, <u>Д.А. Закгейм</u>, <u>С.И. Павлов</u></b> Применение двухслойных пленок ИТО в составе прозрачных и отражающих контактов светодиодов синего и ближнего ультрафиолетового диапазонов
19	<b><u>Д.В. Панькин</u>, <u>М.Б. Смирнов</u></b> Полярные оптические фононы в четырехслойной нитридной сверхрешетке Al <sub>0,5</sub> Ga <sub>0,5</sub> N/GaN/Al <sub>0,5</sub> Ga <sub>0,5</sub> N/AlN
20	<b><u>В.Ю. Давыдов</u>, <u>А.Н. Смирнов</u>, <u>Е.М. Рогинский</u>, <u>Ю.Э. Китаев</u>, <u>М.Б. Смирнов</u>, <u>Р.Н. Кютт</u>, <u>М.А. Яговкина</u>, <u>М.М. Рожавская</u>, <u>Е.Е. Заварин</u>, <u>В.В. Лундин</u>, <u>А.Ф. Цацульников</u></b> Экспериментальные и теоретические исследования фоновонного спектра короткопериодных сверхрешеток GaN/AlN
21	<b><u>С.Ю.Давыдов</u>, <u>О.В. Посредник</u></b> Спонтанная поляризация III-N соединений
22	<b><u>А.Н. Разжувалов</u>, <u>С.Н. Гриняев</u></b> Роль глубоких уровней в токе туннельных диодов W-AlGaN/GaN

	<b>Стендовая сессия В</b>
1	<b><i>Н.Б. Гладышева, М.Е. Гусев, Ю.В. Колковский Ю.А. Концевой, А.Г. Мордовский, Е.Ф. Певцов</i></b> Исследование желтой фотолюминесценции гетерослоёв AlGa <sub>N</sub> /Ga <sub>N</sub>
2	<b><i>С.В. Тарасов, А.Н. Цоцорин, В.И. Дикарев, В.А. Кожевников, Д.М. Красовицкий, С.В. Кокин, В.П. Чалый</i></b> Исследование электрофизических параметров отечественных Ga <sub>N</sub> кристаллов
3	<b><i>Р.Н. Кютт, Д.А. Иванов</i></b> Дефектная структура эпитаксиальных слоев III-нитридов на основе анализа формы дифракционных пиков
4	<b><i>И.А. Белогорохов, А.А. Донсков, Т.Г. Югова, Л.И. Белогорохова</i></b> Фононные моды в полупроводниковых пленках на основе Ga <sub>N</sub>
5	<b><i>Е. А. Шевченко, Д. В. Нечаев, В. Н. Жмерик, Т. В. Шубина, С. В. Иванов, S. Rouvînov, G. Rozîna, J. P. Bergman, В. Монетар, А. А. Торонов</i></b> Рекомбинационная динамика в гетероструктурах с квантовыми ямами на основе Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> N в диапазоне составов 0.6<X<0.8
6	<b><i>М.Г.Попов, В.В.Лундин, Е.Е. Заварин, А.В. Сахаров, В.Ю. Давыдов, А.Н. Смирнов, И.П.Смирнова, М.М.Кулагина, А.Ф. Цацульников</i></b> Селективная МОС-гидридная эпитаксия n <sup>+</sup> Ga <sub>N</sub> и AlGa <sub>N</sub> подконтактных областей
7	<b><i>Е.Е. Заварин, В.В.Лундин, М.Г.Попов, А.В. Сахаров, П.Н. Брунков, М.А. Яговкина, А.Ф. Цацульников</i></b> Конверсионные AlGa <sub>N</sub> /Al <sub>N</sub> сверхрешетки
8	<b><i>А.В.Лютцау, Э.М.Темпер, К.Л.Енишерлова</i></b> Однокристалльная рентгеновская дифрактометрия в технологии AlGa <sub>N</sub> /Ga <sub>N</sub> НЕМТ - транзисторов
9	<b><i>П.С. Вергелес, Е.Б. Якимов</i></b> Стимулированное электронным пучком РЭМ движение дислокаций в Ga <sub>N</sub>
10	<b><i>Ю.В. Федоров, С.В. Михайлович</i></b> Анализ конструктивно-технологических требований к разработке усилителей мощности на нитридных гетероструктурах
11	<b><i>К.С. Журавлев, Н.Н. Новикова, Е.А. Виноградов, В.А. Яковлев, Т.В. Малин, В.Г. Мансуров</i></b> Спектроскопия поверхностных поляритонов нитридизованных подложек сапфира и тонких пленок нитрида алюминия на них

12	<b><u>В.А. Шалыгин, Г.А. Мелентьев, М.Д. Молдавская, Л.Е. Воробьев</u></b> Поверхностные плазмон-поляритоны в нитриде галлия
13	<b><u>А. В. Буташин, А. Э. Муслимов, П. А. Просеков, А. М. Исмаилов, Е. А. Вовк, В. М. Каневский</u></b> Влияние нитридации поверхности (0001) сапфира на рост кристаллических пленок ZnO
14	<b><u>В.Г. Мансуров, Т.В.Малин, Ю.Г. Галицын, К.С. Журавлев</u></b> Кинетика нитридации поверхности (111)Si в потоке аммиака
15	<b><u>Д.Л. Гнатюк, О.С. Матвеев</u></b> Исследование малосигнальных S-параметров пассивных тестовых элементов на гетероструктурах AlGaN/GaN в диапазоне частот до 110 ГГц
16	<b><u>Ю.В. Федоров, Д.Л. Гнатюк, Р.Р. Галиев, М.Ю. Шербакова, А.Ю. Павлов, С.В. Михайлович</u></b> Монолитные интегральные схемы усилителей мощности W-диапазона на основе AlGaN/AlN/GaN/SiC HEMT
17	<b><u>А.В. Саченко, А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, П.Н. Брунков, А.И. Гудыменко, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, П.Н. Романец, П.О. Сай, Н.В. Сафрюк, В.В. Шинкаренко</u></b> Омические контакты к сильнолегированным пленкам p <sup>+</sup> -InN
18	<b><u>Е.В. Ерофеев, В.А. Казадей, А.И. Казимиров, И.В. Федин</u></b> Разработка силовых нормально-закрытых транзисторов на основе эпитаксиальных гетероструктур нитрида галлия для создания энергоэффективной преобразовательной техники
19	<b><u>С.С. Хлудков, И.А. Прудаев, О.П. Толбанов</u></b> Магнитные свойства III-нитридов
20	<b><u>Е.И. Шабунина, М.Е. Левинштейн, М.М. Кулагина, С.Ю. Курин, А.Е. Черняков, В.Н. Петров, В.В. Ратников, И.Н. Смирнова, С.И. Трошков, Н.М. Шмидт, А.С. Усиков, Н. Helava</u></b> Взаимосвязь особенностей ВАХ светоизлучающих гетероструктур на основе AlGaN/GaN со степенью разупорядоченности наноматериала
21	<b><u>И.В. Осинных, Т.В. Малин, К.С. Журавлев</u></b> Подвижная полоса фотолюминесценции в AlGaN/GaN гетероструктурах
22	<b><u>В.И. Николаев, А.И. Печников, В.Н. Маслов, А.А. Головатенко, В.М. Крымов, С.И. Степанов, Н.К. Жумашев, В.Е. Бугров, А.Е. Романов</u></b> Подложки β-Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> для эпитаксии нитрида галлия